AN 1986-146323 [23] WPIDS

(6) AB JP 61079614 A UPAB: 19930922

The surfaces of a pair of moulds are heated by a heater located between the moulds. After the heater is removed, the moulds are clamped to a position where compression vol. 2-20% of the thickness of a final moulded prod. remains. Molten resin is injected into the mould cavity, and the moulds are reclamped to compress the compression vol..

USE/ADVANTAGE - Used for moulding a resin substrate used as an optical disc. Method enables prodn. of a resin substrate having reduced residual stress, resulting in a sharp decrease in birefringence and improvement of quality of optical disc. 0/3

L2 ANSWER 7 OF 14 WPIDS COPYRIGHT 2000 DERWENT INFORMATION LTD

AN 1985-113383 [19] WPIDS

DNC C1985-049060

TI Injection moulding appts. - including hot and cold water circulation loops.

DC A32

PA (SEKI) SEKISUI CHEM IND CO LTD

CYC - 1

PI JP 60054828 A 19850329 (198519)* 4p <--

ADT JP 60054828 A JP 1983-162353 19830902

PRAI JP 1983-162353 19830902

AN 1985-113383 [19] WPIDS

AB JP 60054828 A UPAB: 19930925

A moulding appts. comprises a fixed mould, a movable mould on both sides and a medium path (2) to heat or cool the moulds. A hot water recycling loop, tank (3), water path (13), valve (5), common path (11), medium path (2), common path (12), valve (6) and water path (15) are provided and operated by using valves. Just before opening the moulds air is introduced into the medium path and a prod. is released from the moulds. Hot water is then supplied to the core and melted resin is injected. Just before completion of filling the supply of hot water is stopped and

air is introduced. After completion of filling a cooling water recycling

loop is formed and cooling water is supplied to the core to cool the resin and solidify it.

USE/ADVANTAGE - As hot water and cold water are alternately supplied to

⑩公開特許公報(A)

昭61-79614

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)4月23日

B 29 C 45/56 G 11 B 7/26 7729-4F 8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 樹脂基板の成形方法

②特 願 昭59-203458

②出 願 昭59(1984)9月28日

70発明者 瓜生

良文

千葉県君津郡袖ケ浦町上泉1660番地

砂発 明 者

70代 理

小 林 春 夫

千葉県君津郡袖ケ浦町神納一丁目2番地の1

⑪出 願 人 出光石油化学株式会社

弁理士 木下

實三

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

.

1. 発明の名称

樹脂基板の成形方法

2. 特許請求の範囲

(1) 一対の型の間に加熱手段を介在させてこの加熱手段により前記一対の型の表面を加熱し、加熱手段を取除いた後、前記一対の型を最終成形品の肉厚の2~20%の圧縮代を残した位置まで型締めし、この後前記一対の型に溶融機脂を射出充環するとともに、この一対の型を再型締めして前記圧縮代分を圧縮することを特徴とする機脂基板の成形方法。

(2)前記特許請求の範囲第1項において、前記一対の型に前記容融樹脂を射出充填した後に、この一対の型を再型締めすることを特徴とする樹脂 基板の成形方法。

(3)前記特許請求の範囲第1項において、前,記一対の型に前記容融 樹脂を射出充填しながら、この一対の型を再型締めすることを特徴とする樹脂 基板の成形方法。 3 . 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、光ディスクとして使用される樹脂基板の成形方法に関する。

[背景技術とその問題点]

近年、光メモリーディスクの基板としてポリカーボネート樹脂等の樹脂基板の実用化が検討されている。かかる光ディスクでは透明な基板にピーム光を照射し、反射膜が形成された溝で光を反射させる等して配位信号が読取られるため、光ディスクの品質に複配折が大きく影響する。光ディスクに複屈折が存在すると雑音が発生し、再生信号と雑音信号との比即ち S / N 比が悪くなる。

悲板材料に樹脂を採用したときにおける複屈折は成形時の分子配向による残留応力によって発生する。このため樹脂基板の成形条件を適切に設定することにより、残留応力の少ない基板を得るようにする必要がある。しかし現在まで複屈折の生じない樹脂基板の成形方法は知られていない。

[発明の目的]

本発明者等は、一対の型で樹脂基板を射出成形を発見して型のを予めかり機能を放射出圧縮成形法にきるにはないのは、形を開発を開発を発展したが、大変の目のは、が、大変の対象を変更がある。とができる機能基板の成形方法を提供するところにある。

[問題点を解決するための手段および作用]

このため本発明は、一対の型の間に加熱手段を 介在させてこの加熱手段により前記一対の型内 面を加熱し、加熱手段を取除いた後、前記一対の 型を最終成形品の内厚の2~20%の圧縮代を した位置まで型締めするようにし、そしてこの し記一対の型に溶験樹脂を射出充填すると 前に、この一対の型を再型締めして前記圧縮代分を 圧縮するところに特徴がある。

要するに本発明では、予め表面が加熱された一

前記キャピティ6に溶験樹脂が射出充填される前に固定型1、移動型2の表面1 B 、2 B、換言すると固定型1、移動型2の分割面である前紀凹部4 の底面4 A と凸部5 の頂面5 A 及びぞれらの周辺が高周波加熱装置9 によって加熱装置9 を次のの高周波加熱装置9 を次のなうに製造した。3.5mm 径の鋼管を10mm間隔の沿路状に皿形状にそわせて型を作り、それを2~3 cmの厚さになるようにエポキシ樹脂で注型し、平

[実施例]

第1回に光ディスクとして使用されるのは、 スククとして使用されるののはれるののでは、 こめるののでは、 こめるののでは、 こめるののでは、 このののでは、 このののでは、 このののでは、 このののでは、 このののでは、 このののでは、 このののでは、 このののでは、 このののでは、 こののののでは、 こののののでは、 こののののでは、 こののののでは、 こののののでは、 こののののでは、 こののののでは、 このののののでは、 こののののでは、 このののののでは、 このののののののでは、 このののののでは、 こののののののでは、 このののののでは、 このののののでは、 こののののののでは、 こののののののののでは、 こののののののののののののでは、 こののののののののののでは、 このののののののののでは、 このののののののののでは、 このののののののののでは、 このののののののののでは、 こののののののののののののでは、 こののののののののののののでは、 このののののののののでは、 こののののののののののでは、 こののののののののでは、 こののののののでは、 このののののでは、 このののののののでは、 こののののののでは、 こののののののでは、 このののののでは、 こののののでは、 こののののでは、 このののでは、 このののでは、 このののでは、 このののでは、 このののでは、 このののでは、 このののでは、 こののでは、 このでは、 このでは、

板状に固定固化して高周波加熱装置 9 としてのインダクタを作った。このイングクタによる固定型1、移動型 2 の表面 1 B , 2 B の加熱は、間隔を開けて対峙させた固定型 1、移動型 2 の間にインダクタを配置し、400 KC、150 KWの高周波発振器により5~10秒間発振させて行った。

以上のように固定型1~8 動型2の間に高周波加熱装置9を介在させて固定型1、移動型2の販面1 B,2 Bを加熱する。この加熱作業による表面1 B,2 Bの加熱型度は120℃以上、好ましくは130~150℃とする。120℃以下では成形された樹脂基板の複屈折を低減できず、また150℃以上では表面1 B,2 Bの加熱効率及び冷却効率が低下し、作楽時間が長くなる。

固定型1、移動型2の表面1B,2Bを加熱した後、高周被加熱装置9を取除く。そして固定型1、移動型2に冷却水を流通させず表面1B,2Bの上記温度を維持する。

次いで第2回の通り移動型2の凸部5に案内溝転写用のスタンパ10を取付け、移動型2を固定

.)

第2図の通り固定型1の注入口3に射出シリンダ11のノズル12を接続し、機脂基板の材料としてのポリカーボネート等の溶触機脂13を射出させて注入口3から前記キャビティ6にこの溶験樹脂13を充填する。このとき移動型2には比較的低い圧力ではあるが、固定型1の方向への圧力が加えられているため、溶融機脂13の射出圧力

パ10に形成されている案内講が機脂基板14に 転写される。特に、この再型締めにおける固定型 1、移動型2の圧縮力を200 Kg/cm以上、好ま しくは250 Kg/cmの高圧とする。これにより、 光ディスクとして使用される横脂基板14に記録 される記憶信号用の案内講を正確、確実に転写で きるようになり、優れた転写性が得られるように

以上の成形方法では固定型1、移動型22の再型締めをキャビティ6への溶融機脂13の射出元気の射出元気の対応にながら固定型1、移動型2の再型締めを行ったがら固定型1、移動型2の再型縮約のでは、溶融機脂13の8のでの再型縮めを行いつつ溶融機脂13の残りの型縮めとが同時に行われるため、作薬時間の短縮を図ることができる。

前記高圧再型締め時において、第3図の通り前記ゲートカット用ロッド7を押圧移動させて樹脂

によって移動型 2 が固定型 1 から離れる方向に動くのが防止され、前記圧縮代 d が維持される。

以上のように溶験例脂 1 3 をキャビティ 6 に充填した後、 第 3 図の通り移動型 2 を再度移動させて固定型 1 、 移動型 2 を前記圧縮代 d 分再型締めする。これにより成形品と なる樹脂基板 1 4 が所定の厚さ寸法に成形されるとともに、前記スタン

基板14からゲート部の樹脂14Aを切断する。 この後、移動型2を移動させて固定型1と移動型 2とを型開きし、冷却固化した樹脂基板14を取 出す。

取出された樹脂基板 1 4 は前述のように 固定型 2 1、移動型 2 の 5 0 0 1 1 8 0 0 1 2 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0 0 1 8 0

以上の本実施例では、固定型1、移動型2の装面1B,2Bを加熱する加熱手段として高周波加熱装置を使用したが、高周波加熱装置以外の加熱手段を使用してもよい。しかし高周波加熱装置を使用すると、固定型1、移動型2の加熱節所は装

面1B・2Bだけでよいため、加熱作業を短時間で行え、作案効率の向上を図ることができる。また本実施例では一対の型を左右の固定型と移動型としたが、本発明に係る方法はこれに限らず任意の一対の型を使用しても実施できる。

[発明の効果]

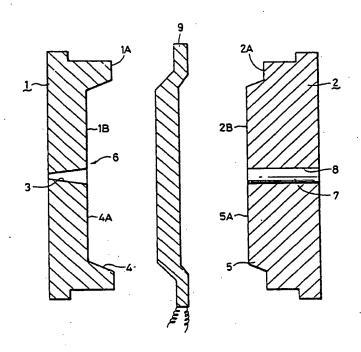
本発明によれば、 残留応力が小さな機能基板を 切ることができるようになり、 従って、 光ディス クの複屈折は極めて小さくなり、 光ディスクの品 質を高めることができる。

4 . 図面の簡単な説明

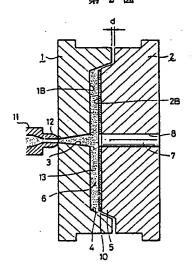
第1図は加熱手段による加熱状態を示す一対の型の縦断面図、第2図は溶験樹脂の射出充填時における一対の型の縦断面図、第3図は再型締め終了後における一対の縦断面図である。

1 , 2 ···一対の型である固定型と移動型、 1 B , 2 B ··· 表面、 9 ···加熱手段である高周被加熱装置、 1 3 ··· 存融樹脂、 1 4 ··· 樹脂基板、 d ··· 压缩代。

第 1 図







第 3 図

